#### 02

# Упругое рассеяние электронов на атомах европия и иттербия

© В.И. Келемен, Е.Ю. Ремета

Институт электронной физики НАН Украины, 88017 Ужгород, Украина e-mail: vlad.kelemen@gmail.com; remetov@inbox.ru

#### (Поступило в Редакцию 9 октября 2012 г.)

В рамках метода релятивистского оптического потенциала исследовано упругое рассеяние электронов на атомах европия и иттербия в широкой области энергий столкновений вплоть до 2 keV. Угловые зависимости дифференциальных сечений рассеяния и энергетические зависимости интегральных сечений рассеяния (полного, упругого, передачи импульса и вязкости) рассчитаны как в спин-поляризованном, так и в спиннеполяризованном приближениях. Показано, что для случая атома европия при расчете сечений рассеяния для энергий меньше 10 eV необходимо использовать спин-поляризованное приближение. Низкоэнергетическое рассеяние электрона на атоме европия характеризуется наличием *P*-, *D*- и *F*-резонансов формы. Для атома иттербия получено хорошее согласие сечений рассеяния с имеющимися экспериментальными данными и релятивистским расчетом в приближении метода сходящейся сильной связи.

### Введение

Среди лантаноидов периодической таблицы ряд элементов с конфигурацией [Xe] $4f^n6s^2$  имеет заполняющуюся субвалентную 4f-подоболочку (n = 3-7 и 9–14). Ранее наибольший интерес был проявлен к исследованию процесса рассеяния электронов на двух атомах этого ряда: Eu( $4f^76s^2$ ) и Yb( $4f^{14}6s^2$ ). Рассеяние электронов атомами Yb было достаточно полно исследовано в теоретических [1–7] и экспериментальных [8–10] работах.

Гораздо меньше опубликовано результатов по рассеянию электронов на атомах Еu. Экспериментальными методами наиболее полно были исследованы интегральные сечения возбуждения и ионизации атома европия [9] (см. также ссылки там). Что касается упругого рассеяния, то была измерена лишь энергетическая зависимость дифференциального сечения (ДС) на 90° в интервале энергий 1-10 eV в относительных единицах [11]. Ранее в сообщении [12] нами были представлены данные теоретического исследования сечений рассеяния для энергий 0.1-100 eV в методе оптического потенциала (ОП) с некоторым учетом зависимости обменного взаимодействия от ориентации спинов налетающего электрона и атома-мишени. В [13] в полурелятивистском приближении комплексного ОП были рассчитаны сечения рассеяния и параметры спиновой поляризация (функции S, U и T) в области энергий налетающих электронов 2-500 eV. Недавно в [6,14] были представлены результаты вычислений ДС упругого рассеяния электронов на некоторых атомах лантаноидов, в том числе на атоме Eu [14], при низких до 1 eV энергиях. Для вычислений там был использован потенциал рассеяния Томаса-Ферми-типа с двумя подгоночными параметрами.

Следует отметить, что атом европия является единственным удобным элементом с полузаполненной  $f^7$ -подоболочкой для экспериментального исследования рассеяния поляризованных электронов на поляризованной мишени, поскольку атом америция (Z = 95) с такой подоболочкой ( $5f^7$ ) является искусственным элементом. Поэтому представляет определенный интерес теоретическое исследование рассеяния электрона на атоме Eu с учетом зависимости взаимодействия между ними от взаимной ориентации их спинов.

В работе авторов [15] спиновая обменная асимметрия  $A(E, \theta)$  и ДС упругого *e*-Еи рассеяния были исследованы в спин-поляризованном приближении при 10 eV для оптических потенциалов с учетом зависимости от спина не только обменного, но и корреляционно-поляризационного взаимодействия. В сообщении [16] была представлена угловая зависимость функции асимметрии  $A(E, \theta)$  для этого процесса при нескольких энергиях налетающего электрона. В частности, там было продемонстрировано, что при энергиях *D*- и *F*-резонансов формы асимметрия достигает почти 100%.

В настоящей работе упругое е-Еи рассеяние исследовано в широком интервале энергий 0.05-2000 eV и с более полным учетом релятивистских эффектов в рассеянии, чем это было сделано в [15,16]. Рассчитаны угловые зависимости ДС и энергетические зависимости интегральных сечений рассеяния: полного, упругого, передачи импульса и вязкости. Сравнение дифференциальных и интегральных сечений рассеяния, рассчитанных в спин-поляризованном и спин-неполяризованном приближениях, позволило для случая атома европия определить энергии столкновений, при которых в расчетах можно пренебречь зависимостью от ориентации спинов электрона и атома мишени. Получены положения низкоэнергетических резонансов формы. Проведено сравнение вычисленных нами сечений с теоретическими результатами из [13].

В [15] для 10 eV и здесь для энергий из интервала 10-200 eV получено существенное отличие наших сечений *e*-Eu рассеяния от данных из [13]. Учитывая подобие электронных оболочек атомов европия и иттербия, в настоящей работе авторы провели расчеты сечений рассеяния также и для атома иттербия. В отличие от наших предыдущих расчетов [4,5] для этого атома, здесь для учета релятивистских эффектов в рассеянии кроме потенциала спин-орбитального взаимодействия использована также и скалярная часть релятивистского дираковского потенциала [17–19]. Хорошее согласие полученных результатов для Yb с экспериментом [10] и релятивистским расчетом в приближении метода сходящейся сильной связи (RCCC) [7] позволило нам применить данный метод релятивистского оптического потенциала и для исследования упругого рассеяния электронов на атомах Eu.

## 1. Теоретический метод

## Оптический потенциал в спин-поляризованном приближении (SPA) для рассеяния электрона на атоме европия

Электронная конфигурация основного состояния атома европия с полузаполненной  $4f^7$ -подоболочкой имеет максимальный спин 7/2. Следовательно, электроны этой подоболочки имеют сонаправленные спины, например, условного направления вверх. Это дает возможность использовать разбиение всей электронной оболочки атома (N = 63 электрона) на две заполненные спиновые оболочки — 35 электронов спина вверх  $(sp = \uparrow)$  и 28 электронов спина вниз  $(sp = \downarrow)$ . В результате расчета атомных характеристик имеем электронные плотности: две спиновые  $\rho_{\uparrow}(r)$  и  $\rho_{\perp}(r)$  и полную  $\rho(r) = \rho_{\uparrow}(r) + \rho_{\downarrow}(r)$ .

Рассеяние электронов на атоме европия может быть рассмотрено для двух случаев взаимной ориентации спинов налетающего электрона и атома мишени. Во-первых, когда направления этих спинов совпадают — рассеяние с параллельными ( $\uparrow\uparrow$ ) спинами. И во-вторых, когда спины имеют противоположные направления — рассеяние с антипараллельными ( $\downarrow\uparrow$ ) спинами. Таким образом, рассеяние электрона спин-поляризованным атомом будет описываться двумя ОП ( $\lambda = \uparrow\uparrow, \downarrow\uparrow$ ) [15,20]

$$V_{\text{opt}}^{\lambda,\pm}(r,E) = V_R^{\lambda,\pm}(r,E) + i V_a^{\lambda}(r,E).$$
(1)

Используем атомную систему единиц (a.e.):  $\hbar = e = m_e = 1, E = k^2/2$  — энергия и k — импульс налетающего электрона. Обозначение  $\pm$  подразумевает величину полного углового момента электрона  $j = \ell \pm 1/2$ , где  $\ell$  — угловой орбитальный момент электрона.

Вещественная часть  $V_R^{\lambda,\pm}(r, E)$  ОП — это сумма потенциалов: статического  $V_{\rm st}(r)$ , обменного  $V_{\rm ex}^{\lambda}(r, E)$ , поляризационного  $V_{\rm pol}^{\lambda}(r)$ , спин-орбитального взаимодействия  $V_{\rm so}^{\pm}(r, E)$  и скалярной части релятивистского

дираковского потенциала VRS(r, E)

$$V_R^{\lambda,\pm}(r,E) = V_{\rm st}(r) + V_{\rm ex}^{\lambda}(r,E) + V_{\rm pol}^{\lambda}(r) + V_{\rm so}^{\pm}(r,E) + VRS(r,E).$$
(2)

Мнимая часть  $V_a^{\lambda}(r, E)$  ОП в (1) — это потенциал поглощения.

Статический потенциал  $V_{\rm st}(r)$ , электронные плотности (полная ho(r) и спиновые  $ho_{
m sp}(r)$ ) вычислены в самосогласованном атомном расчете в рамках скалярнорелятивистского и локальной спиновой плотности приближений теории функционала плотности (ТФП) с исключением энергии самодействия электронов (см., например, [1]). Эти величины рассчитываются по аналитическим выражениям того же типа, что и в [21] (см. уравнения (A1) и (A2) в Приложении А). Параметры для расчета электронных плотностей получены из наилучшего приближения к исходным таблицам плотностей и приведены в Приложениях А и В для европия и в Приложении С для иттербия. Поскольку выражение (A1) для  $V_{st}(r)$  связано с выражением (A2) для  $\rho(r)$  [21], то для расчета статического потенциала использованы те же параметры, что и для полной плотности.

Для учета обменного взаимодействия используем потенциал в приближении свободного неоднородного электронного газа (см., например, выражение (2) в [1] и ссылки там). При рассеянии электрона с фиксированным направлением спина на спин-поляризованной системе обменное взаимодействие происходит только с соответствующей спиновой подоболочкой. Поэтому, как и в [15,20], используем два значения импульса Ферми  $k_F^{sp}(r) = [6\pi^2 \rho_{sp}(r)]^{1/3}$  ( $sp = \uparrow, \downarrow$ ). В результате имеем два обменных потенциала

$$V_{\rm ex}^{\lambda}(r,E) = -\frac{k_F^{sp}(r)}{\pi} \left( 1 + \frac{1 - \eta_{sp}^2}{2\eta_{sp}} \ln \left| \frac{1 + \eta_{sp}}{1 - \eta_{sp}} \right| \right).$$
(3)

Для случая рассеяния с параллельными спинами используется  $V_{ex}^{\uparrow\uparrow}$  с  $k_F^{\uparrow}$ , а для рассеяния с антипараллельными спинами —  $V_{ex}^{\downarrow\uparrow}$  с  $k_F^{\downarrow}$ . В (3)  $\eta_{sp}(r, E) = k_s^{sp}(r, E)/k_F^{sp}(r)$  и импульс рассеивающегося электрона на расстоянии *r* от атома  $k_s^{sp}(r, E)$  имеет вид (ср. с выражением (5) в [1])

$$[k_s^{sp}(r, E)]^2 = k^2 + [k_F^{sp}(r)]^2 + 2I / \left[1 + \frac{1}{2}(kr)^2\right].$$
 (4)

Используемый при расчетах  $V_{\rm ex}$  потенциал ионизации для атома Eu  $I = 5.67045 \, {\rm eV}$  взят из [22], а для атома Yb — потенциал  $I = 6.354 \, {\rm eV}$  был рассчитан в [1] в том же приближении, что и  $\rho(r)$ .

Поляризационный потенциал состоит из двух частей, описывающих взаимодействие на малых (SR) и больших (LR) расстояниях (см., например, [15,20] и ссылки там):

$$V_{\text{pol}}^{\lambda}(r) = \begin{cases} V p_{\text{SR}}^{\lambda}(r), & r \le r_c^{\lambda}, \\ V p_{\text{LR}}(r), & r > r_c^{\lambda}. \end{cases}$$
(5)

Во внутренней области атома при  $r \leq r_c^{\lambda}$  потенциал определяется корреляционным взаимодействием налетающего электрона с *N*-электронами мишени и имеет вид

$$V p_{\rm SR}^{\lambda}(r) = \varepsilon_c(r_s,\xi) - \frac{r_s}{3} \frac{\partial \varepsilon_c}{\partial r_s} \pm (1 \mp \xi) \frac{\partial \varepsilon_c}{\partial \xi}, \quad (6)$$

где верхний и нижний знаки соответствуют случаям  $\lambda = \uparrow \uparrow$  и  $\lambda = \downarrow \uparrow$ . В (6)  $\varepsilon_c[r_s(r), \xi(r)]$  — это плотность корреляционной энергии, зависящая от спиновой поляризации  $\xi(r) = [\rho_{\uparrow}(r) - \rho_{\downarrow}(r)]/\rho(r)$  и радиуса Вигнера  $r_s(r) = \{3/[4\pi\rho(r)]\}^{1/3}$  (см. Приложение в [15]).

На расстояниях  $r > r_c^{\lambda}$  потенциал (5) имеет хорошо известный асимптотический вид  $V p_{LR}(r) = -\alpha_d(0)/2r^4$  (см., например, уравнение (10) в [15] и ссылки там), где  $\alpha_d(0)$  — статическая дипольная поляризуемость атомамишени. Величины поляризуемостей атомов европия и иттербия вычислены в локальном приближении времязависящей ТФП с релятивистским эффективным локальным потенциалом и равны:  $\alpha_d = 204.4a_0^3$  [15] для Еи и  $\alpha_d = 167.84a_0^3$  [1] для Yb.

В случае рассеяния с параллельными спинами ( $\lambda = \uparrow \uparrow$ ) две части поляризационного потенциала (5), а именно  $V p_{SR}^{\uparrow\uparrow}(r)$  и  $V p_{LR}(r)$  пересекаются первый раз в точке  $r_c^{\uparrow\uparrow} = 9.544a_0$ . В другом случае ( $\lambda = \downarrow \uparrow$ ) две части поляризационного потенциала  $V p_{SR}^{\downarrow\uparrow}(r)$  и  $V p_{LR}(r)$  пересекаются первый раз в точке  $r_c^{\downarrow\uparrow} = 11.6a_0$ .

Спин-орбитальное взаимодействие налетающего электрона с атомом-мишенью, как и в [19], учтено с помощью потенциала

$$V_{\rm so}^{\pm}(r,E) = \xi^{\pm}(j,\ell)\frac{\chi}{r}\frac{dV_{\rm st}}{dr}, \quad \chi = \alpha^2/[2+\alpha^2(E-V_{\rm st})], \tag{7}$$

где  $\xi^+(j, \ell) = l/2$  для  $j = \ell + 1/2$  и  $\xi^-(j, \ell) = -(\ell + 1)/2$  для  $j = \ell - 1/2$ ,  $\alpha$  — постоянная тонкой структуры. Для учета скалярных релятивистских поправок используется потенциал Дирака [17–19]

$$VRS(r, E) = -\frac{\alpha^2}{2}V_{\rm st}^2 + \frac{\chi}{4}\frac{d^2V_{\rm st}}{dr^2} + \frac{3\chi^2}{8}\left(\frac{dV_{\rm st}}{dr}\right)^2.$$
 (8)

Для энергий столкновения выше первого неупругого порога  $\Delta = 1.60235 \text{ eV}$  для европия и  $\Delta = 2.14351 \text{ eV}$ для иттербия [22], эффекты поглощения учтены мнимой частью  $V_a^{\lambda}(r, E)$  оптического потенциала (1). Как правило, в качестве потенциала  $V_a^{\lambda}$  используется модифицированная версия неэмпирического потенциала поглощения в модели квазисвободного рассеяния электронов (см. [23] и ссылки там). Этот потенциал пропорционален локальной скорости  $v_{\text{loc}}$  налетающего электрона. В спинполяризованном приближении для двух спиновых потенциалов поглощения

$$Vaf 2m_{\lambda}(r, E) = -\nu_{\rm loc}^{\lambda}(r, E)\rho(r)\overline{\sigma}_{b}^{\lambda}(r, E)/2 \qquad (9)$$

имеем две локальные скорости  $v_{\rm loc}^{\lambda} = [2T_{\rm loc}^{\lambda}]^{1/2}$ , где локальная кинетическая энергия равна  $T_{\rm loc}^{\lambda} = E - V_{\rm st}$ 

 $-V_{\rm ex}^{\lambda} - V_{\rm pol}^{\lambda} - VRS$ . Усредненное сечение бинарных столкновений  $\overline{\sigma}_{b}^{\lambda}(r, E)$  (см. выражение (5) в [23]) и, следовательно, соответствующая версия  $Vaf2m_{\lambda}$  определяются параметрами  $\alpha_{\lambda}(r, E)$  и  $\beta_{\lambda}(r, E)$  в виде (ср. с выражениями (21а) и (21b) в [23]):

$$\alpha_{\lambda}(r, E) = k_F^2(r) + \Delta$$
$$-2[V_{\rm st}(r) + V_{\rm ex}^{\lambda}(r, E) + V_{\rm pol}^{\lambda}(r) + VRS(r, E].$$
$$\beta_{\lambda}(r, E) = \alpha_{\lambda}(r, E). \tag{10}$$

Здесь локальный импульс Ферми  $k_F(r) = [3\pi^2 \rho(r)]^{1/3}$  определяется полной электронной плотностью атома  $\rho(r)$ .

Как и в наших предыдущих работах [5,15], в определенных случаях в качестве потенциала  $V_a^{\lambda}$  в (1) используется одна из версий эмпирического потенциала поглощения McCarthy-типа [24] (см. также уравнение (17) в [23] и дискуссию там) в виде

$$VaMc_{\lambda}(r, E) = -W_{\lambda}(E)r^{2}\rho_{H}(r)/\left[T_{\text{loc}}^{\lambda}(r, E)\right]^{2}.$$
 (11)

Здесь  $W_{\lambda}(E)$  — феноменологический параметр и  $\rho_H(r)$  — электронная плотность внешней заполненной оболочки. В качестве  $\rho_H$  взяли электронную плотность валентной  $6s^2$ -подоболочки  $\rho_{6s}$  атомов европия и иттербия. В результате аппроксимации исходных табличных данных по методу наименьших квадратов наилучшее приближение для  $\rho_{6s}$  получено в виде аналитических выражений (B1) и (B2) (см. Приложение В). Параметры для одноэлектронных орбиталей Слэтэра  $\varphi_{6s}$  (B2) для Еu приведены в Приложении В и для Yb — в Приложении С. Значения параметров  $W_{\lambda}(E)$  в (11), так же как и в [5,15,19,25], получены из условия воспроизведения соответствующих сечений поглощения  $\sigma_{abs}^{\lambda}(E)$ , рассчитанных с использованием потенциала  $Vaf 2m_{\lambda}$  (9).

## 1.2. Оптический потенциал в спин-неполяризованном локальном приближении (LA) для рассеяния электронов на атомах европия и иттербия

В работах [13,25] для расчета сечений рассеяния электрона атомом с незаполненной оболочкой, так же как и в случае атомов Yb и Hg, имеющих заполненную оболочку, использован локальный ОП (см., например, [1,3–5,19]). Этот потенциал не зависит от взаимной ориентации спинов налетающего электрона и атомамишени. Ниже, использование такого потенциала будем называть спин-неполяризованным приближением (LA):

$$V_{\text{opt}}^{\pm}(r, E) = V_R^{\pm}(r, E) + iV_a(r, E),$$
 (12)

$$V_{R}^{\pm}(r, E) = V_{st}(r) + V_{ex}(r, E) + V_{pol}(r) + V_{so}^{\pm}(r, E) + VRS(r, E).$$
(13)

Представляет определенный интерес сравнение результатов расчетов сечений рассеяния для европия, проведенных в спин-поляризованном (SPA) и локальном (LA) приближениях. Ниже расчеты, проведенные в приближении релятивистских комплексных ОП (1) и (12), называются RSEPA-расчетами, а расчеты в приближении вещественных частей этих ОП (2) и (13) — RSEP-расчетами.

Для учета обменного взаимодействия  $(V_{ex}(r, E))$ в (13), так же как и в спиновом случае, используется приближение свободного неоднородного электронного газа, но с импульсом Ферми  $k_F(r)$ , зависящим от полной плотности электронов  $\rho(r)$ .

Так же как и выше (см. выражение (5)), поляризационный потенциал  $V_{\text{pol}}(r)$  в (13) состоит из двух частей: короткодействующей  $V_{\text{pol}}^{\text{SR}}(r)$  и дальнодействующей  $V_{\text{pol}}^{\text{LR}}(r)$ . Точка их первого пересечения для европия есть  $r_c = 10.447a_0$  и для иттербия —  $r_c = 10.573a_0$ . Потенциал  $V_{\text{pol}}^{\text{SR}}(r)$  равен потенциалу  $Vp_{\text{SR}}^{\lambda}(r)$  (6) для случая, когда функция спиновой поляризации  $\xi(r) = 0$ . Это приближение соответствует корреляционному взаимодействию в парамагнитном спин-неполяризованном электронном газе (см. дискуссию в [15]).

Потенциал поглощения  $V_a(r, E)$  в ОП (12) выбирается в виде либо потенциала Vaf2m(r, E), либо потенциала VaMc(r, E). Вид этих потенциалов такой же, как и выражения (9) и (11), но для спин-неполяризованного случая. Вспомогательные величины для потенциалов поглощения Vaf2m и VaMc определяются с использованием локальных потенциалов  $V_{ex}$  и  $V_{pol}$ .

#### 1.3. Расчет парциальных фазовых сдвигов и характеристик рассеяния

В результате вычислений в приближении ОП (1) и (12) имеем наборы комплексных парциальных фазовых сдвигов:  $\delta_{\ell}^{\lambda,\pm}(E) = \varepsilon_{\ell}^{\lambda,\pm}(E) + i\mu_{\ell}^{\lambda,\pm}(E)$  и  $\delta_{\ell}^{\pm}(E) = \varepsilon_{\ell}^{\pm}(E) + i\mu_{\ell}^{\pm}(E)$  соответственно. Расчеты в приближении вещественных частей ОП (2) и (13) дают наборы вещественных парциальных фазовых сдвигов:  $\delta_{\ell}^{\lambda,\pm}(E)$  и  $\delta_{\ell}^{\pm}(E)$  соответственно. Для получения фазовых сдвигов рассеяния используется метод фазовых сдвигов используется система двух связанных первого порядка нелинейных дифференциальных фазовых уравнений для двух фазовых функций  $\varepsilon_{\ell}^{\pm}(r, E)$  и  $\eta_{\ell}^{\pm}(r, E)$ . Абсолютные значения фазовых сдвигов получаем как пределы этих фазовых функций

$$arepsilon_\ell^\pm(E) = \lim_{r o \infty} arepsilon_\ell^\pm(r, E),$$
 $\mu_\ell^\pm(E) = -rac{1}{2} \ln \left[ \lim_{r o \infty} \eta_\ell^\pm(r, E) 
ight].$ 

При выборе граничных условий для интегрирования фазовых уравнений использовано поведение вещественной части оптического потенциала на малых расстояниях  $r \ge r_0$ :

$$V_R^{\pm}(r) pprox V_0 r^p [1+Ar^s], \quad p>-2, \quad s>0$$

Малость величины  $r_0$  для тяжелых атомов ограничивается тем условием, что кулоновское поведение потенциала  $V_{\rm st}(r)$  на расстояниях  $r < Z/c^2$  может быть не справедливым [17]. В данном случае, например, для *s*-волны используем значение  $r_0 = 0.006a_0$ . Тогда начальное значение фазовой функции  $\varepsilon_{\ell}^{\pm}(r)$  находится по выражению (2.8) из [27]. Начальное значение для другой фазовой функции есть  $\eta_{\ell}^{\pm}(r) = 1$ . Численный метод получения парциальных фазовых сдвигов тот же, что и в наших предыдущих работах (см., например, [1,4,5,19]).

Для энергий столкновения  $E < \Delta$  потенциалы поглощения по определению равны нулю. Также эти потенциалы равны нулю и на малых радиальных расстояниях. Так, потенциал квазисвободного рассеяния Vaf 2m (9) равен нулю на расстояниях, где сечение  $\overline{\sigma}_{b}(r, E) = 0$ для  $k^2 < \alpha + \beta - k_F^2$  (см. [23] и ссылки там). Потенциал McCarthy-типа (11) на малых расстояниях пренебрежимо мал по сравнению с вещественной частью ОП. Например, для случая атома иттербия для  $E = 10 \, \text{eV}$ и  $r = 0.1a_0$  потенциал  $V_R = -4.4 \cdot 10^2$  (a. u.), а мнимая часть ОП потенциал  $VaMc = -4.9 \cdot 10^{-11}$  (a. u.). Поэтому, для расстояний  $r < 0.1a_0$  полагаем, что VaMc = 0. Для всех случаев, когда мнимая часть ОП равна нулю, система фазовых уравнений сводится к одному фазовому уравнению [26,27] (см. также уравнение (42) в [1]). Оно используется также и в RSEP-приближении для расчета вещественных парциальных фазовых сдвигов.

Спин-орбитальное расщепление между фазами  $\delta_{\ell}^+$ и  $\delta_{\ell}^-$  учитывается до такого значения орбитального момента  $\ell = L_1$ , начиная с которого  $|\varepsilon_{\ell}^+ - \varepsilon_{\ell}^-| < 0.005\%$  и  $|\mu_{\ell}^+ - \mu_{\ell}^-| < 0.005\%$ . Для  $\ell > L_1$  полагаем, что  $\delta_{\ell}^+ = \delta_{\ell}^-$ . Например, для случая атома иттербия для энергии 1000 eV получили, что  $L_1 = 56$ .

Максимальное количество комплексных парциальных фазовых сдвигов, вычисляемых с помощью системы фазовых уравнений, определялось из двух условий. Вопервых, необходимо, чтобы для данной энергии и орбитального момента  $\ell = L_2$  мнимая часть фазового сдвига  $\mu_{\ell}$  должна быть настолько малой, чтобы знаменатель  $\exp(2\mu_{\ell})$  в парциально-волновом разложении "прямой"  $f(E, \theta)$  и "с переворотом спина"  $g(E, \theta)$  амплитуд рассеяния с учетом точности расчета ДС, можно было положить равным 1. Полагаем, что такому требованию вполне удовлетворяют значения  $\mu_{\ell} < 10^{-4}$  rad. Вовторых, для  $\ell = L_2$  разница вещественной части фазового сдвига  $\varepsilon_{\ell}$  и асимптотического значения фазы  $\delta_{\ell}^{as}$  должна удовлетворять неравенству:  $|\varepsilon_{\ell} - \delta_{\ell}^{as}| < |\varepsilon_{\ell-1} - \delta_{\ell-1}^{as}|$ . Фазовый сдвиг  $\delta_{\ell}^{as}$  рассчитывается по хорошо известной формуле (см., например, уравнение (56) в [1] и ссылки там). В зависимости от значения энергии величина L<sub>2</sub> различна. Так, для случая атома иттербия для  $1000 \,\mathrm{eV}$  мы получили, что  $L_2 = 88$ , а соответствующее значение фазового сдвига (в радианах)  $\delta_{88}(1000) = 6.70 \cdot 10^{-3} + i 1.36 \cdot 10^{-5}$ . Тогда для  $\ell > L_2$ полагаем, что  $\varepsilon_{\ell} = \delta_{\ell}^{as}$  и  $\mu_{\ell} = 0$ .



Рис. 1. Энергетическая зависимость упругого (*a*), передачи импульса (*b*) и вязкости (*c*) сечений *e*-Yb рассеяния (в 10<sup>-20</sup> m<sup>2</sup>). Сплошная линия соответствует RSEPA-расчетам (12) с потенциалом поглощения *Vaf2m*, штриховая — RSEP-расчетам (13) без учета поглощения. Другие теоретические данные: ▼ — расчеты с комплексным ОП [3], △ — RCCC [7]. Экспериментальные данные: ● — [10].

Поскольку в RSEP-расчетах  $\delta_{\ell}^{\pm}(E) \equiv \varepsilon_{\ell}^{\pm}(E)$ , то значения  $L_1$  и  $L_2$  определяются по тем же условиям, что и для  $\varepsilon_{\ell}$ . Всего при расчетах амплитуды  $f(E, \theta)$  учитывался вклад до 300 парциальных волн.

Дифференциальное сечение упругого рассеяния определяем как среднее двух спиновых сечений параллельного  $d\sigma^{\uparrow\uparrow}/d\theta$  и антипараллельного  $d\sigma^{\downarrow\uparrow}/d\theta$  рассеяния (см. уравнение (12) в [15]). Спиновые сечения  $d\sigma^{\lambda}/d\theta$ определены через соответствующие  $f^{\lambda}(E, \theta)$  и  $g^{\lambda}(E, \theta)$ амплитуды (см. выражения (13) и (14) в [15]), которые рассчитаны с использованием спиновых фазовых сдвигов  $\delta^{\lambda,\pm}_{\ell}(E)$ .

Интегральные сечения — упругое ( $\sigma_{\rm el}$ ), поглощения ( $\sigma_{\rm abs}$ ), передачи импульса ( $\sigma_{\rm mom}$ ) и вязкости ( $\sigma_{\rm vis}$ ) — определяем как среднее соответствующих спиновых сечений рассеяния  $\sigma(E) = (\sigma^{\uparrow\uparrow}(E) + \sigma^{\downarrow\uparrow}(E))/2$ . Для расчета спиновых сечений  $\sigma^{\lambda}(E)$  используем те же формулы, что и в [15]. Полное сечение рассеяния найдено как сумма  $\sigma_{\rm tot} = \sigma_{\rm el} + \sigma_{\rm abs}$ .

Для спин-неполяризованного приближения при расчете амплитуд и сечений рассеяния используются те же выражения, что и для спинового случая, но без индекса " $\lambda$ ".

## 2. Обсуждение результатов

#### 2.1. Сечения рассеяния для Yb

Поскольку в литературе для случая атома иттербия имеются эспериментальные данные [10] и результаты недавних релятивистских расчетов в приближении метода сходящейся сильной связи (RCCC) [7], то сначала представим наши расчеты сечений рассеяния электрона на этом атоме. Как было указано выше, в расчетах с учетом эффектов поглощения (RSEPA-приближение) в качестве мнимой части ОР (12) нами, как правило, используется неэмпирический потенциал поглощения Va f 2m (9). Проведенный с использованием этого потенциала поглощения RSEPA-расчет интегральных сечений рассеяния упругого  $\sigma_{el}(E)$ , передачи импульса  $\sigma_{mom}(E)$ и вязкости  $\sigma_{vis}(E)$  хорошо согласуется с экспериментом [10] (рис. 1).



**Рис. 2.** Угловая зависимость дифференциальных сечений (в  $10^{-20} \text{ m}^2 \text{ sr}^{-1}$ ) упругого *e*-Yb рассеяния при энергиях налетающего электрона 10 (*a*), 20 (*b*), 40 (*c*), 50 (*d*), 60 (*e*) и 80 (*f*) eV. Сплошная линия соответствует RSEPA-расчетам (12) с потенциалами поглощения *VaMc* для 10 eV и *Vaf 2m* для E > 10 eV, штриховая — RSEP-расчетам (13) без учета поглощения. Другие теоретические данные: пунктир — [2], штриховая линия с двумя точками — [3], штрихпунктир — [7]. Экспериментальные данные:  $\circ - [10]$ .

Как видно на рис. 1, *a*, наш RSEPA-расчет  $\sigma_{\rm el}$  хорошо согласуется с RCCC-расчетом [7]. Расчет из работы [3] дал существенно завышенные значения  $\sigma_{\rm el}$  для всех энергий. Сравнение на рис. 1, *b* и *c* RSEP- и RSEPA-расчетов сечений  $\sigma_{\rm mom}$  и  $\sigma_{\rm vis}$  наглядно демонстрирует, что учет поглощения заметно улучшил согласие наших данных с экспериментом. Отметим, что расчет  $\sigma_{\rm mom}$ 

из [3] хорошо согласуется с нашим RSEP-расчетом, хотя и был проведен в приближении комплексного ОП.

На рис. 2 приведены угловые зависимости ДС при энергиях налетающего электрона 10, 20, 40, 50, 60 и 80 eV. При этих энергиях имеются экспериментальные [10] и теоретические [2,3,7] данные. В нашей предыдущей работе [5] было продемонстрировано, что



**Рис. 3.** То же, что и на рис. 2, но для энергий 100 (*a*) и 200 (*b*) eV.

при расчете ДС для 10 eV предпочтительнее использовать потенциал поглощения VaMc (11). Как видно на рис. 2, *a*, экспериментальное сечение для 10 eV имеет два локальных минимума. Подобное поведение ДС было получено в расчетах: релятивистском без учета поглощения [2], RCCC [7] и данном RSEP. В RSEPA-расчете с использованием потенциала поглощения VaMc[W(10) = 0.2424 a. u.] мы получили хорошее согласие с экспериментом для углов рассеяния меньше 40° и больше 100°. Учет поглощения дал низкоугловой минимума при 50° более широкий, чем в RSEP-расчете. Все эти расчеты дали положение высокоуглового минимума при ~125°. Отметим, что ДС в [3] имеет один минимум при 115° и не воспроизводит форму экспериментальной угловой зависимости ДС.

Для  $E \ge 20 \text{ eV}$  RSEPA-расчеты ДС мы провели с использованием потенциала поглощения Va f 2m (9). Как видно на рис. 2, *b*, *c*, *e*, *f*, эти расчеты хорошо согласуются с экспериментом и RCCC-расчетами.

Как видно на рис. 2, d для 50 eV, есть некоторое качественное согласие между нашими расчетами и ДС из [3]. Однако для 100 eV (рис. 3, a) расчет из [3] для углов больше 45° сильно отличается от нашего

и RCCC-расчета. Для 200 eV отличие между нашим расчетом и ДС из [3] при средних углах остается, особенно в интервале углов 110–150°.

Приведенное выше сравнение наших расчетов для иттербия в приближении релятивистского оптического потенциала с экспериментом [10] и RCCC-расчетами [7] позволяет нам использовать данное приближение и для исследования упругого рассеяния электрона на атоме европия.

#### 2.2. Сечения рассеяния для Eu

На рис. 4 приведены RSEP- и RSEPА-расчеты интегральных сечений рассеяния электрона на атоме европия в широкой области энергий столкновения вплоть до 2 keV. В качестве потенциала поглощения использован неэмпирический потенциал  $Va f 2m_{\lambda}(9)$ . Расчеты показали, что для  $E < 10 \, \text{eV}$  необходимо использовать спин-поляризованное (SPA) приближение с потенциалами (1) и (2). Таким образом, для  $E \ge 10 \, \text{eV}$  расчеты сечений можно провести в более простом спиннеполяризованном локальном приближении (LA) с потенциалами (12) и (13). В таблице приведены энергии и ширины резонансов формы, рассчитанные в этих приближениях. Основное различие между SPA- и LA-расчетами получено для положения *F*-резонанса формы. В результате в интегральных сечениях структура при 4 eV будет только в спин-поляризованном приближении (рис. 4). Низкоэнергетические максимумы в сечениях при  $\sim 0.1$  и  $\sim 1 \, {\rm eV}$  обусловлены вкладом *P*- и *D*-резонансов формы соответственно.

На рис. 4 наши расчеты сравнены с расчетом в приближении комплексного ОП из [13]. Как видно на рис. 4, *a*, эти расчеты полного сечения  $\sigma_{tot}(E)$  начиная с 30 eV согласуются друг с другом. Для упругого сечения  $\sigma_{el}(E)$  начиная с 50 eV имеется качественное согласие наших расчетов с данными из [13] (рис. 4, *b*). Как видно на рис. 4, *c*, начиная с 200 eV наш RSEPA-расчет сечения передачи импульса  $\sigma_{mom}(E)$  согласуется с сечением из [13]. Наш расчет сечения вязкости  $\sigma_{vis}(E)$  представлен на рис. 4, *d*. Отметим нерегулярное спадание этого сечения в интервале энергий 10–300 eV. Наш расчет  $\sigma_{vis}$  носит предсказательный характер, в связи

Энергии  $E_r$  и ширины  $\Gamma$  резонансов формы в упругом *e*-Eu-pacсеянии, рассчитанные в спин-поляризованном (SPA) и спиннеполяризованном (LA) приближениях

l	j	SPA, $\lambda = \uparrow \uparrow$		SPA, $\lambda = \downarrow \uparrow$		LA	
		$E_r$ , eV	Γ,eV	$E_r$ , eV	Γ,eV	$E_r$ , eV	Γ, eV
1	1/2	0.077	0.085	0.078	0.129	0.079	0.108
	3/2	0.072	0.159	0.077	0.222	0.076	0.197
2	3/2	0.80	0.32	1.17	0.91	0.99	0.57
	5/2	0.91	0.48	1.24	1.10	1.09	0.75
3	5/2	0.351	0.001	4.04	0.10	1.02	0.01
	7/2	0.403	0.001	4.75	0.17	1.64	0.02



**Рис. 4.** Энергетические зависимости полного (*a*), упругого (*b*), передачи импульса (*c*) и вязкости (*d*) сечений *e*-Eu рассеяния (в  $10^{-20}$  m<sup>2</sup>). Для  $E \le 10$  eV расчеты проведены в SPA-приближении (потенциалы (1) и (2)). Для E > 10 eV расчеты проведены в LA-приближении (потенциалы (12) и (13)). Сплошная линия соответствует RSEPA-расчетам с потенциалом поглощения Vaf 2m, штриховая — RSEP-расчетам без учета поглощения. Другие теоретические данные:  $\nabla$  — расчеты с комплексным ОП [13].

с чем заметим, что в литературе имеются экспериментальные измерения этого сечения для ряда атомов (см., например, данные для Yb [10], Hg [19] и In [25]).

На рис. 5 сравнены наши расчеты угловой зависимости ДС в LA-приближении с сечениями, рассчитанными в [13] с использованием комплексного ОП. Данные RSEPA-расчеты, так же как и для атома Yb, для 10 eV проведены с использованием потенциала поглощения VaMc[W(10) = 0.2931 a. u.], а для бо́льших энергий с потенциалом Vaf 2m.

Так же как и в случае атома Yb, для 10 eV (рис. 5, *a*) имеется существенное качественное отличие нашего расчета от данных из [13]. Для 50 и 100 eV (рис. 5, *b* и *c*) имеется как качественное, так и количественное различие наших ДС для углов больше  $50^{\circ}$  и  $30^{\circ}$  соответственно. И наконец, для 200 eV (рис. 5, *d*) наши расчеты и ДС из [13] в основном согласуются друг с другом, а различия имеются лишь в окрестностях локальных минимумов и максимума при  $90^{\circ}$ .

## Заключение

В методе релятивистского оптического потенциала исследовано упругое рассеяние электронов на тяжелых атомах европия и иттербия. Использованы два

Журнал технической физики, 2013, том 83, вып. 12

приближения в рамках теории функционала плотности — спин-поляризованное и спин-неполяризованное. Для атома иттербия получено хорошее согласие сечений рассеяния с имеющимися в литературе экспериментальными данными и недавним релятивистским расчетом в приближении метода сходящейся сильной связи. Это позволило применить данный метод релятивистского ОП для случая атома европия, учитывая подобие их электронных оболочек.

Упругое рассеяние электронов на атомах европия исследовано в широкой области энергий столкновений 0.05–2000 eV. Расчеты проведены в двух приближениях: спин-поляризованном и спин-неполяризованном. Рассчитаны угловые зависимости дифференциальных сечений рассеяния и энергетические зависимости интегральных сечений рассеяния: полного, упругого, передачи импульса и вязкости. Показано, что при расчете сечений рассеяния для энергий меньше 10 eV необходимо использовать спин-поляризованное приближение. Для бо́льших энергий может быть использовано более простое спиннеполяризованное приближение.

Для энергий выше неупругого порога расчеты характеристик рассеяния проведены как в приближении комплексного ОП (с учетом эффектов поглощения), так и в приближении действительной части ОП (без учета эффектов поглощения). В качестве потенциалов



**Рис. 5.** Угловая зависимость дифференциальных сечений (в  $10^{-20} \text{ m}^2 \text{ sr}^{-1}$ ) упругого *e*-Eu рассеяния при энергиях налетающего электрона 10 (*a*), 50 (*b*), 100 (*c*) и 200 (*d*) eV. Сплошная линия соответствует RSEPA-расчетам (12) с потенциалами поглощения VaMc для 10 eV и Vaf 2m для E > 10 eV. Штриховая линия соответствует RSEP-расчетам (13) без учета поглощения. Другие теоретические данные: штрихпунктир — [13].

поглощения используется, как правило, неэмпирический потенциал. При расчете ДС для 10 eV использован феноменологический потенциал. В целом учет эффектов поглощения приводит к уменьшению значений ДС практически для всего интервала углов рассеяния в области энергий вплоть до 500 eV, а для интегральных сечений передачи импульса и вязкости к значительному уменьшению их величины для энергий от неупругого порога и до 400 eV.

Низкоэнергетическое рассеяние электрона на атоме европия характеризуется наличием *P*-, *D*- и *F*-резонансов формы. Наибольшая разница между энергиями резонансов для случаев параллельного и антипараллельного рассеяния получена для *F*-резонансов. Два максимума в интегральных сечениях в окрестности 4 eV обусловлены вкладом *F*-резонансов для антипараллельного случая при 4.04 и 4.75 eV для значений полных угловых моментов электрона 5/2 и 7/2 соответственно.

Проведено сравнение наших результатов для европия с имеющимися в литературе теоретическими данными. Некоторое согласие наших ДС с этими данными имеется лишь для энергии 200 eV. Для интегральных сечений даже при 500 eV отличие нашего упругого сечения от другого расчета является существенным и составило больше 20%. Полученные в настоящей работе результаты, а также отличие их от других теоретических данных могли бы стимулировать экспериментальные и новые теоретические исследования процесса упругого рассеяния электронов на атомах европия в широкой области энергий столкновений.

Авторы весьма признательны проф. А.N. Tripathi за предоставление копии своей статьи по европию [13].

# Приложение А. Аналитические выражения и значения параметров для статического потенциала $V_{\rm st}(r)$ , полной $\rho(r)$ и спиновых электронных плотностей $\rho_{\rm sp}(r)$ для атома Eu

Статический потенциал  $V_{\rm st}(r)$  и полная электронная плотность  $\rho(r)$  вычисляются с использованием аналити-

ческих выражений, подобных выражениям в [21]:

$$V_{\rm st}(r) = -\frac{Z}{r} \left[ \sum_{i=1}^{n} A_i \exp(-B_i r) + r \sum_{j=1}^{m} C_j \exp(-D_j r) \right],$$
(A1)
$$\rho(r) = \frac{N}{4\pi r} \left[ \sum_{i=1}^{n} A_i B_i^2 \exp(-B_i r) + \sum_{j=1}^{m} C_j D_j (D_j r - 2) \exp(-D_j r) \right],$$
(A2)

где Z — это заряд ядра атома-мишени и N — количество электронов в атомной оболочке.

В выражениях (A1) и (A2) суммирование проводится до n = 6 и m = 6. Параметры A, B, C и D имеют следующие значения:  $A_1 = 2.42676$ ,  $A_2 = -10.382$ ,  $A_3 = 8.719$ ,  $A_4 = -4.5297$ ,  $A_5 = 4.7816$  и  $A_6 = 1 - A_1 - A_2 - A_3 - A_4 - A_5$  являются безразмерными;  $B_1 = 3.4819$ ,  $B_2 = 35.953$ ,  $B_3 = 10.376$ ,  $B_4 = 1.265$ ,  $B_5 = 1.43$ ,  $B_6 = 285.81$ ,  $C_1 = -10.679$ ,  $C_2 = -88.801$ ,  $C_3 = -176.09$ ,  $C_4 = -7.9359$ ,  $C_5 = 0.6589$ ,  $C_6 = -1.5666$ ,  $D_1 = 58.798$ ,  $D_2 = 13.152$ ,  $D_3 = 26.536$ ,  $D_4 = 5.0605$ ,  $D_5 = 1.261$  и  $D_6 = 233.02$  — в единицах  $a_0^{-1}$ ;  $a_0$  — первый радиус Бора атома водорода.

Для расчета спиновых плотностей  $\rho_{\rm sp}(r)$  также используем выражение (A2), но с заменой  $N \to N_{\rm sp}$ , суммирование в этих случаях проводится также до n = 6 и m = 6. Для  $\rho_{\uparrow}(r)$  число электронов в sp = $\uparrow$  подоболочке  $N_{\uparrow} = 35$  и параметры A, B, C и D имеют следующие значения:  $A_1 = 3.1302$ ,  $A_2 = -9.4059$ ,  $A_3 = 6.53$ ,  $A_4 = -0.01447$ ,  $A_5 = -0.274$  и  $A_6 = 1.0342$  — безразмерные;  $B_1 = 4.9232$ ,  $B_2 = 35.82$ ,  $B_3 = 11.371$ ,  $B_4 = 282.84$ ,  $B_5 = 1.119$ ,  $B_6 = 2.19$ ,  $C_1 = -1.4242$ ,  $C_2 = -9.4333$ ,  $C_3 = -76.936$ ,  $C_4 = -158.801$ ,  $C_5 = -9.1644$ ,  $C_6 = 0.1941$ ,  $D_1 = 230.72$ ,  $D_2 = 59.148$ ,  $D_3 = 13.181$ ,  $D_4 = 26.482$ ,  $D_5 = 5.7358$  и  $D_6 = 1.2025$  — в единицах  $a_0^{-1}$ .

Для  $\rho_{\downarrow}(r)$  число электронов в sp =  $\downarrow$  подоболочке  $N_{\downarrow} = 28$  и параметры A, B, C и D имеют значения:  $A_1 = 2.0314$ ,  $A_2 = -11.4461$ ,  $A_3 = 10.2483$ ,  $A_4 = -0.01769$ ,  $A_5 = -11.829$  и  $A_6 = 12.013$  — безразмерные;  $B_1 = 3.2291$ ,  $B_2 = 36.053$ ,  $B_3 = 9.962$ ,  $B_4 = 285.26$ ,  $B_5 = 1.2626$ ,  $B_6 = 1.3426$ ,  $C_1 = -12.066$ ,  $C_2 = -99.967$ ,  $C_3 = -195.268$ ,  $C_4 = -7.0444$ ,  $C_5 = 0.8908$ ,  $C_6 = -1.7633$ ,  $D_1 = 58.776$ ,  $D_2 = 13.091$ ,  $D_3 = 26.559$ ,  $D_4 = 4.9105$ ,  $D_5 = 1.245$  и  $D_6 = 232.58$  — в единицах  $a_0^{-1}$ .

## Приложение В. Аналитические выражения и значения параметров для плотности $\rho_{6s}(r)$ и орбитали $\varphi_{6s}(r)$ валентной $6s^2$ -подоболочки атома Eu

Аналитическое выражение для плотности валентной 6*s*<sup>2</sup>-подоболочки имеет вид

$$\rho_{6s}(r) = 2\varphi_{6s}^2(r), \tag{B1}$$

где слэтэровская одноэлектронная орбиталь (см., например, [22] и ссылки там) рассчитывается по формуле

$$\varphi_{6s}(r) = \sum_{i=1}^{5} K_i r^{M_i} \exp(-N_i r).$$
(B2)

Параметры в уравнении (B2) имеют следующие значения:  $K_1 = 12.005$ ,  $K_2 = -44.855$ ,  $K_3 = -11.179$ ,  $K_4 = -6.383$ ,  $K_5 = 12.266$ ;  $M_1 = -0.3199$ ,  $M_2 = 0.4018$ ,  $M_3 = -0.86615$ ,  $M_4 = -0.5477$ ,  $M_5 = -0.8584$ ;  $N_1 = 6.4126$ ,  $N_2 = 17.969$ ,  $N_3 = 0.572$ ,  $N_4 = 3.4907$ ,  $N_5 = 0.6268$ . Значения параметров  $M_i$  — безразмерные, а  $N_i$  — в единицах  $a_0^{-1}$ . Размерность параметров  $K_i$ определяется нормировкой плотности  $\rho_{6s}$ .

# Приложение С. Значения параметров для статического потенциала $V_{\rm st}(r)$ , полной электронной плотности $\rho(r)$ и плотности валентной $6s^2$ -подоболочки $\rho_{6s}(r)$ для атома Yb

Для атома иттербия статический потенциал  $V_{\rm st}(r)$ , полная электронная плотность  $\rho(r)$  и плотность валентной  $6s^2$ -подоболочки рассчитаны с использованием аналитических выражений (A1), (A2) и (B1) соответственно. Суммирование в выражениях (A1) и (A2), так же как и для случая атома европия, проводится до n=6 и m=6. Параметры A, B, C и D имеют следующие значения:  $A_1=-0.8471$ ,  $A_2=-9.7784$ ,  $A_3=10.751$ ,  $A_4=-0.13473$ ,  $A_5=1.0121$ ,  $A_6=1-A_1-A_2-A_3-A_4-A_5$  являются безразмерными;  $B_1=4.3997$ ,  $B_2=40.546$ ,  $B_3=9.2425$ ,  $B_4=$ = 1.176,  $B_5=2.65$ ,  $B_6=300$ ,  $C_1=-10.51$ ,  $C_2=-103.01$ ,  $C_3=-185.95$ ,  $C_4=-9.2274$ ,  $C_5=0.14928$ ,  $C_6=2.3618$ ,  $D_1=72.511$ ,  $D_2=14.773$ ,  $D_3=30.19$ ,  $D_4=9.7994$ ,  $D_5=1.261$ ,  $D_6=109.03$ — в единицах  $a_0^{-1}$ .

Для расчета одноэлектронной орбитали  $\varphi_{6s}(r)$ атома Yb использовано уравнение (B2) с параметрами:  $K_1 = 13.918$ ,  $K_2 = -50.875$ ,  $K_3 = 3.2264$ ,  $K_4 = -4.0087$ ,  $K_5 = -1.9392$ ;  $M_1 = -0.28581$ ,  $M_2 =$ = 0.2727,  $M_3 = -0.96418$ ,  $M_4 = -0.71864$ ,  $M_5 = -1.0068$ ;  $N_1 = 9.0491$ ,  $N_2 = 18.767$ ,  $N_3 = 0.80842$ ,  $N_4 = 3.1507$ ,  $N_5 = 0.48222$ . Значения параметров  $M_i$  — безразмерные, а  $N_i$  — в единицах  $a_0^{-1}$ . Размерность параметров  $K_i$ определяется нормировкой плотности  $\rho_{6s}$ .

#### Список литературы

- [1] Kelemen V.I., Remeta E.Yu., Sabad E.P. // J. Phys. B. 1995. Vol. 28. P. 1527–1546.
- [2] Yuan J. // Phys. Rev. A. 1995. Vol. 52. P. 4647-4655.
- [3] Neerja, Tripathi A.N., Jain A.K. // Phys. Rev. A. 2000. Vol. 61.
   P. 032 713.
- [4] Kelemen V.I., Dovhanych M.M., Remeta E.Yu. // J. Phys. B. 2008. Vol. 41. P. 035 204.

- [5] Kelemen V.I., Dovhanych M.M., Remeta E.Yu. // J. Phys. B. 2008. Vol. 41. P. 125 202.
- [6] Felfli Z., Msezane A.Z., Sokolovski D. // Phys. Rev. A. 2009. Vol. 79. P. 02 714.
- Bostock C.J., Fursa D.V., Bray I. // Phys. Rev. A. 2011. Vol. 83.
   P. 052 710.
- [8] Казаков С.М., Христофоров О.В. // Опт. и спектр. 1983.
   Т. 54. С. 750–752.
- [9] Шимон Л.Л. Эффективные сечения возбуждения и ионизации атомов редкоземельных элементов. М.: Энергоатомиздат, 1994. 144 с.
- [10] Predojević B., Šević D., Pejčev V., Marinković B.P., Filipović D.M. // J. Phys. B. 2005. Vol. 38. P. 1329–1340, 3489–3501.
- [11] Казаков С.М., Христофоров О.В. // ЖЭТФ. 1984. Т. 86. С. 835–846.
- [12] Sabad E., Kelemen V., Remeta E. // Proc. XVIII Intern. Conf. on Phys. Electronic and Atomic Collisions. Denmark: Aarhus, 1993. P. 134.
- [13] Neerja, Tripathi A.N. // Eur. Phys. J. D. 2001. Vol. 13. P. 5-10.
- [14] Felfli Z., Msezane A.Z., Sokolovski D. // Phys. Rev. A. 2009. Vol. 79. P. 062 709.
- [15] Remeta E.Yu., Kelemen V.I. // J. Phys. B. 2010. Vol. 43. P. 045 202.
- [16] Kelemen V.I., Remeta E.Yu. // Proc. 5<sup>th</sup> Conf. on Elementary Process in Atomic Systems. Belgrad. Serbia, 2011. P. W9.
- [17] Фок В.А. Начала квантовой механики. М.: Наука, 1976. 376 с.
- [18] Sin Fai Lam L.T. // J. Phys. B. 1982. Vol. 15. P. 119–142.
- [19] Kelemen V.I., Remeta E.Yu. // J. Phys. B. 2012. Vol. 45. P. 185 202.
- [20] Ремета Е.Ю., Келемен В.И. // ЖТФ. 2010. Т. 80. Вып. 12. С. 18–26.
- [21] Strand T.G., Bonham R.A. // J. Chem. Phys. 1964. Vol. 40.
   P. 1686–1691.
- [22] Радциг А.А., Смирнов Б.М. Параметры атомов и атомных ионов. Справочник. М, 1986. 344 с.
- [23] Staszewska G., Schwenke D.W., Truhlar D.G. // Phys. Rev. A. 1984. Vol. 29. P. 3078–3091.
- [24] McCarthy I, Noble C, Phillips B, Turnbull A. // Phys. Rev. A. 1977. Vol. 15. P. 2173–2185.
- [25] Rabasović M.S., Kelemen V.I., Tošić S.D., Šević D., Dovhanych M.M., Pejčev V., Filipović D.M., Remeta E.Yu., Marinković B.P. // Phys. Rev. A. 2008. Vol. 77. P. 062 713.
- [26] Калоджеро Ф. Метод фазовых функций в теории потенциального рассеяния / Пер. с англ. М.: Мир, 1972. 292 с.
- [27] Бабиков В.В. Метод фазовых функций в квантовой механике. М.: Наука, 1988. 256 с.